

## Lagenaufbau

Ebe	ene		Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Тур
		A	Cu+galv.Cu		18+25	
1			Prepreg	0.068		1080
			Prepreg	0.068		1080
2			Cu Tr-Lam	0.20	35	
	V		Cu	0.20	35	
3			Prepreg	0.068		1080
		<u></u>	Prepreg	0.068		1080
4			Cu Tr-Lam	0.20	35	
_			Cu		35	
5			Prepreg	0.068		1080
		<u></u>	Prepreg	0.068		1080
6			Cu+galv.Cu		18+25	

Presslingsdicke *	0,96	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstoppmaske *	1,07	+/- 10%

## Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- \* Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 ungefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

## Designrules zum Lagenaufbau





Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 150 µm				
(1.00)	Viapad-Ø	≥ 450 µm				
Leiterbild Außenlagen						
	Laitarbraita bai Qum Grundkunfar	> 90 um				
	Leiterbreite bei 9 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 9 µm Grundkupfer	≥ 80 µm ≥ 100 µm				
	Leiterabstand bei 9 µm Grundkuprei	= 100 μπ				
Ctondord	Laitambraita hai 10 um Crundluntar	>100				
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥100 µm				
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 120 µm				
		> 120				
	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥ 130 µm ≥ 175 µm				
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer					
	Laitarbraita bai 70 um Crundkunfar	> 100 um				
	Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer	≥ 190 µm ≥ 240 µm				
	Leiterabstand bei 70 µm Ordnakupier	= 240 μπ				
Leiterbild Innenlagen						
	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 65 µm				
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 80 µm				
Standard	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥85 µm				
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 100 µm				